

บทที่ 4

ผลการวิจัย

บทนี้กล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากการทดลองตามแนวทางการศึกษาในบทที่ 3 ตั้งแต่การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเตรียมพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ การหาอัตราเคลือบของพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ การศึกษาสมบัติของพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ที่เคลือบได้และที่ผ่านการอบอ่อน โดยสมบัติที่จะศึกษาได้แก่ โครงสร้างพลีก ลักษณะพื้นผิว และสมบัติทางแสง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับเคลือบพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์

การเคลือบพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีรีแอคทีฟ ดีซี สปีดเตอริง ซึ่งมีความยุ่งยากกว่าการเคลือบด้วยวิธีสปีดเตอริงธรรมชาติ ในประเด็นของการควบคุมปริมาณแก๊สที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ การทดลองนี้เป็นการหาอัตราส่วนของแก๊สสารกอนต่อแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ โดยใช้ชิลิกอนเวฟอร์ เป็นวัสดุรองรับ งานนี้จึงเคลือบพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สสารกอนต่อแก๊สต่อออกซิเจนเท่ากับ 1: 2, 1: 4 และ 1: 8

ผลการเคลือบพิล์มนบางไทยเนี่ยม โดยออกใช้ค์ที่อัตราส่วนของแก๊สสารกอนต่อแก๊สออกซิเจนต่างๆ ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 4-1)

1. เมื่อใช้อัตราส่วนแก๊สสารกอนต่อแก๊สออกซิเจน เท่ากับ 1: 2 พนว่า เครื่องเคลือบไม่สามารถสร้างโกล์วิดิษาร์จได้ ทำให้ไม่เกิดการสปีดเตอร์ จึงไม่สามารถเคลือบพิล์มนที่เงื่อนไขนี้ได้ (ความดันรวมของเคลือบท่ากับ 1.9×10^{-3} mbar)

2. เมื่อใช้อัตราส่วนแก๊สสารกอนต่อแก๊สออกซิเจน เท่ากับ 1: 4 พนว่า เครื่องเคลือบสามารถสร้างโกล์วิดิษาร์จได้ และเมื่อทำการเคลือบเป็นเวลา 180 นาที พนพิล์มนบางเกิดขึ้นบนวัสดุรองรับ ซึ่งพิล์มนบางที่เกิดขึ้นมีลักษณะใส (ความดันรวมของเคลือบท่ากับ 3.1×10^{-3} mbar)

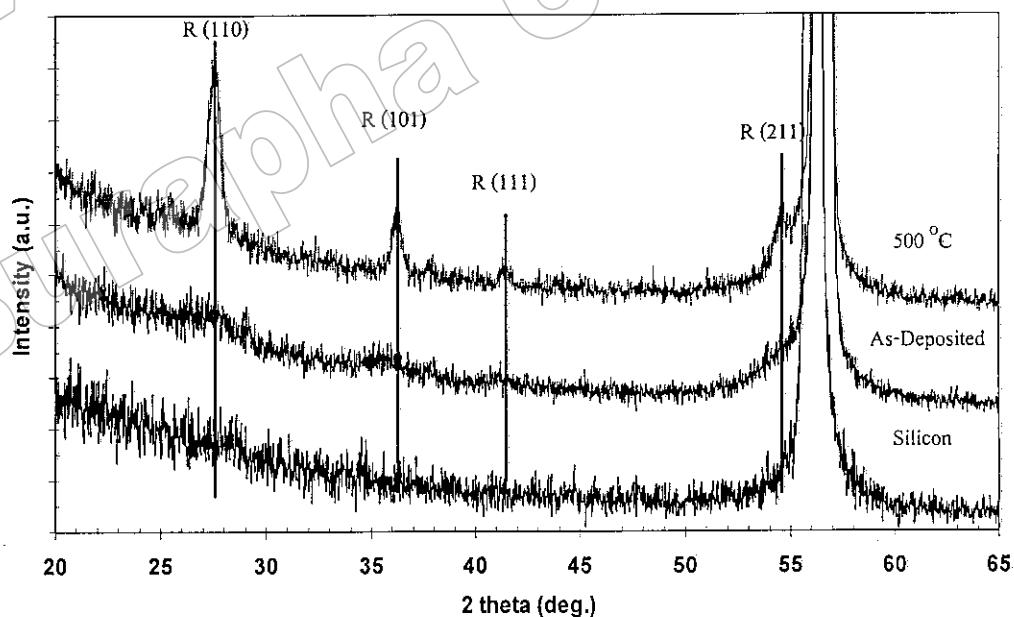
3. เมื่อใช้อัตราส่วนแก๊สสารกอนต่อแก๊สออกซิเจน เท่ากับ 1: 8 พนว่า เครื่องเคลือบสามารถสร้างโกล์วิดิษาร์จได้ และเมื่อทำการเคลือบเป็นเวลา 180 นาที ไม่พนพิล์มนบางเกิดขึ้นบนวัสดุรองรับ (ความดันรวมอยู่ในช่วง 6×10^{-3} - 8×10^{-3} mbar)

ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบโครงสร้างพลีกของพิล์มนบางที่เคลือบได้เมื่อใช้อัตราส่วนแก๊สสารกอนต่อแก๊สออกซิเจน เท่ากับ 1: 4 ได้นำพิล์มนบางที่ได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างพลีกด้วยเทคนิค

XRD ได้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ดังภาพที่ 4-1 ซึ่งไม่พบพีก แสดงว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบอัมอร์ฟาน (Amorphous) ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบผลเจ็บน้ำฟิล์มบางดังกล่าวไปอบอ่อนในบรรยายกาศที่อุณหภูมิ 500°C แล้วนำໄไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD อีกครั้ง พบร่วมกับพีกเดียวที่มุม 27.5 , 36.1 , 41.3 และ 54.4 องศา เมื่อนำฟิล์มที่มุ่งดังกล่าวไปเทียบกับพีกมาตรฐาน (JCPDS) พบร่วมกับพีกเดียวที่มุม (110) , (101) , (111) และ (211) ตามลำดับ

ตารางที่ 4-1 ผลการเคลือบฟิล์มบางไทยทานียมโดยออกไซด์ที่อัตราส่วนแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ

อัตราส่วน Ar:O ₂	โคล์ดดิสชาร์จ	ฟิล์ม	ความดันรวม
1: 2	ไม่เกิด	ไม่เกิดฟิล์ม	1.9×10^{-3} mbar
1: 4	เกิด	เกิดฟิล์ม	3.1×10^{-3} mbar
1: 8	เกิด	ไม่เกิดฟิล์ม	6×10^{-3} - 8×10^{-3} mbar



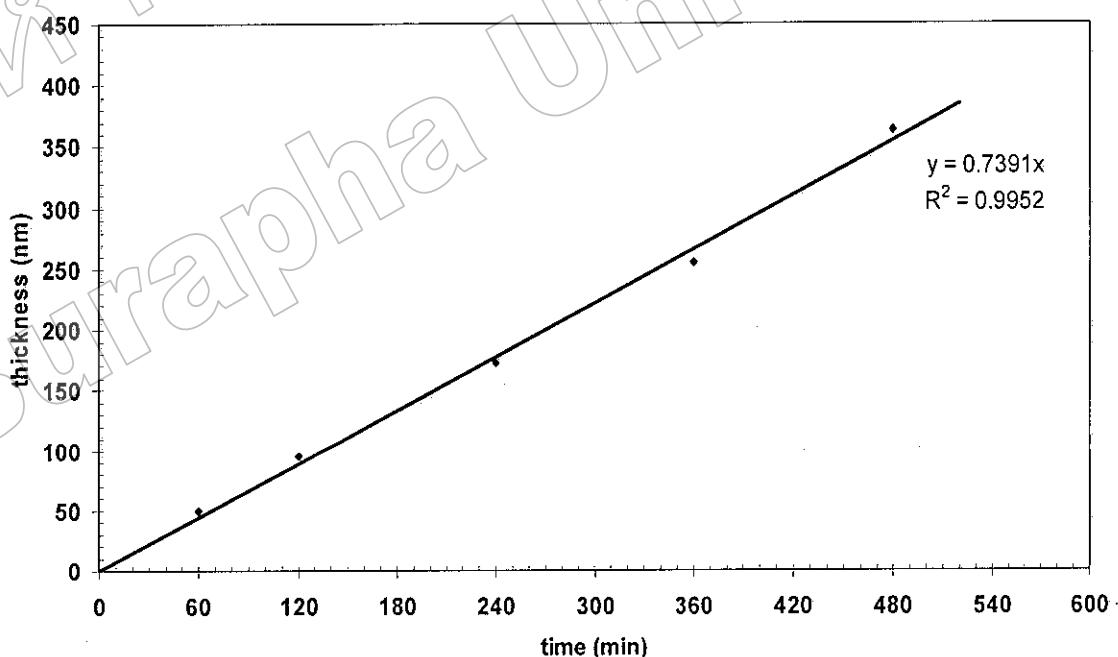
ภาพที่ 4-1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของวัสดุรองรับ ฟิล์มบางที่เคลือบได้ และฟิล์มบางที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 500°C

การหาอัตราเคลือบของฟิล์มนางไทยเนี่ยม ไโคออกไซด์

ความหนาของฟิล์มนางที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี สปิตเตอริง ทำได้โดยการควบคุมเวลาที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มแต่ละครั้ง สำหรับความหนาของฟิล์มนางในการศึกษานี้จะควบคุมเวลา เคลือบ โดยพิจารณาจากอัตราเคลือบของฟิล์มนางไทยเนี่ยม ไโคออกไซด์ ทั้งนี้อัตราเคลือบหนาได้ ค่าความชันของกราฟความหนาฟิล์มและเวลา

งานวิจัยนี้ได้ทดลองหาอัตราเคลือบของฟิล์มนางไทยเนี่ยม ไโคออกไซด์โดยการนำฟิล์ม ที่เคลือบได้ไปวัดความหนาด้วยเทคนิค AFM โดยความหนาของฟิล์มนางที่เคลือบที่เวลาต่างๆ

จากการศึกษาพบว่า เมื่อเวลาที่ใช้เคลือบเพิ่มขึ้นความหนาฟิล์มนางจะเพิ่มขึ้น โดยที่เวลา ที่ใช้ในการเคลือบ 60 min จะได้ความหนา 50.23 nm และเพิ่มขึ้นเป็น 95.31, 172.16, 255.00 และ 363.27 nm ที่เวลา 120, 240, 360 และ 480 min ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อนำผลที่ได้มาเขียนกราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาฟิล์มกับเวลาในการเคลือบ พบว่า เมื่อเวลาในการเคลือบเพิ่มขึ้น ความหนาฟิล์มนางจะเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเส้น (ภาพที่ 4-2) โดยมีความชันเท่ากับ 0.739 ($R^2=0.9952$) ดังนั้นอัตราเคลือบของฟิล์มนางไทยเนี่ยม ไโคออกไซด์ในการศึกษานี้เท่ากับ 0.74 nm/min



ภาพที่ 4-2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาฟิล์มกับเวลาในการเคลือบ

ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มน้ำยาท่านเนยมไดออกไซด์

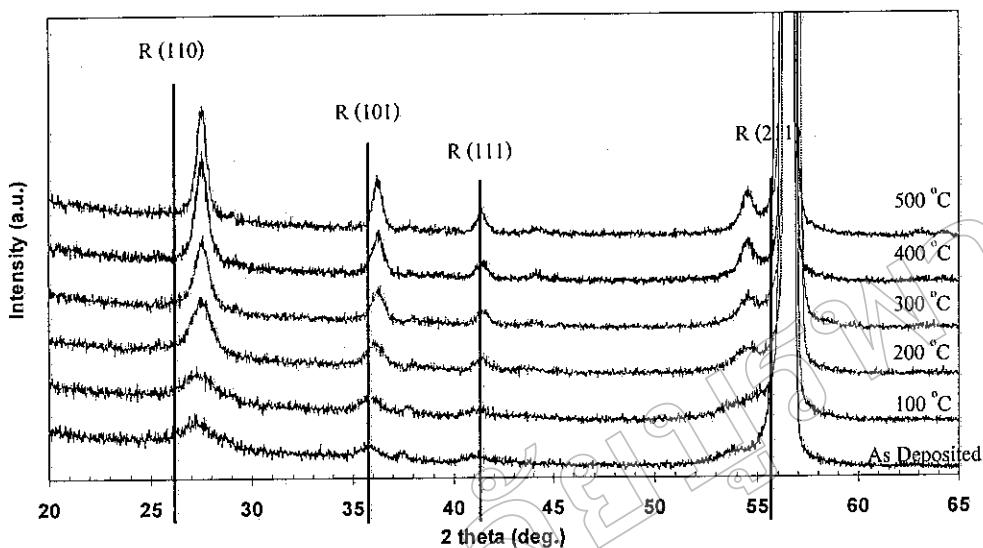
สิ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มน้ำยาท่านเนยมไดออกไซด์คืออุณหภูมิ อบอ่อน การทดลองนี้ใช้เงื่อนไขการเคลือบแสดงดังตารางที่ 4-5 โดยนำฟิล์มน้ำยาที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ซึ่งผลแสดงดังภาพที่ 4-3

ภาพที่ 4-3 เป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มน้ำยาที่เคลือบที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบว่า ฟิล์มน้ำยาที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องไม่พบพิกัดของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แต่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มีลักษณะคล้ายโดม ที่มุม 27.5, 36.1 และ 41.3 องศา เมื่อบรรผิญเทighbกับพิคมาตรฐาน JCPDS พบว่าเป็นมุนของไทยาเนยมไดออกไซด์เฟสทรูไทด์ที่ระนาบ (110), (101) และ (111) ตามลำดับ แสดงว่าที่อุณหภูมิห้อง ฟิล์มน้ำยาที่เคลือบได้เริ่มแสดงความเป็นผลึกของไทยาเนยมไดออกไซด์ เฟสทรูไทด์

เมื่อนำฟิล์มน้ำยาที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100°C พบว่า รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีลักษณะของโดมเหมือนกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มน้ำยาที่อุณหภูมิห้อง แสดงว่าฟิล์มน้ำยาที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100°C ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก

สำหรับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มน้ำยาที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดมที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอบอ่อน 100°C เริ่มแสดงความเป็นพิกมากขึ้นแต่ฐานของพิกยังคงกว้างอยู่ นอกจากนี้ยังปรากฏโดมใหม่เกิดขึ้นที่มุม 54.4 องศา ซึ่งเมื่อตรวจสอบกับพิคมาตรฐาน JCPDS พบว่าเป็นพิกของไทยาเนยมไดออกไซด์เฟสทรูไทด์ที่ระนาบ (211)

ที่อุณหภูมิอบอ่อน 300°C รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แสดงให้เห็นลักษณะของพิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือความสูงของพิกสูงขึ้น รวมทั้งฐานของพิกแคบลง ส่วนโดมที่มุม 54.4 องศา เริ่มเปลี่ยนเป็นพิกชัดเจนขึ้น และเมื่อนำฟิล์มน้ำยาไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 400 และ 500°C พบว่าพิกที่มุม 27.5, 36.1, 41.3 และ 54.4 องศา แสดงความเป็นพิกได้อย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของรูปแบบการเลี้ยวเบนทำให้ทราบว่าฟิล์มน้ำยาไทยาเนยมไดออกไซด์มีความเป็นผลึกมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนมีค่าสูงขึ้น

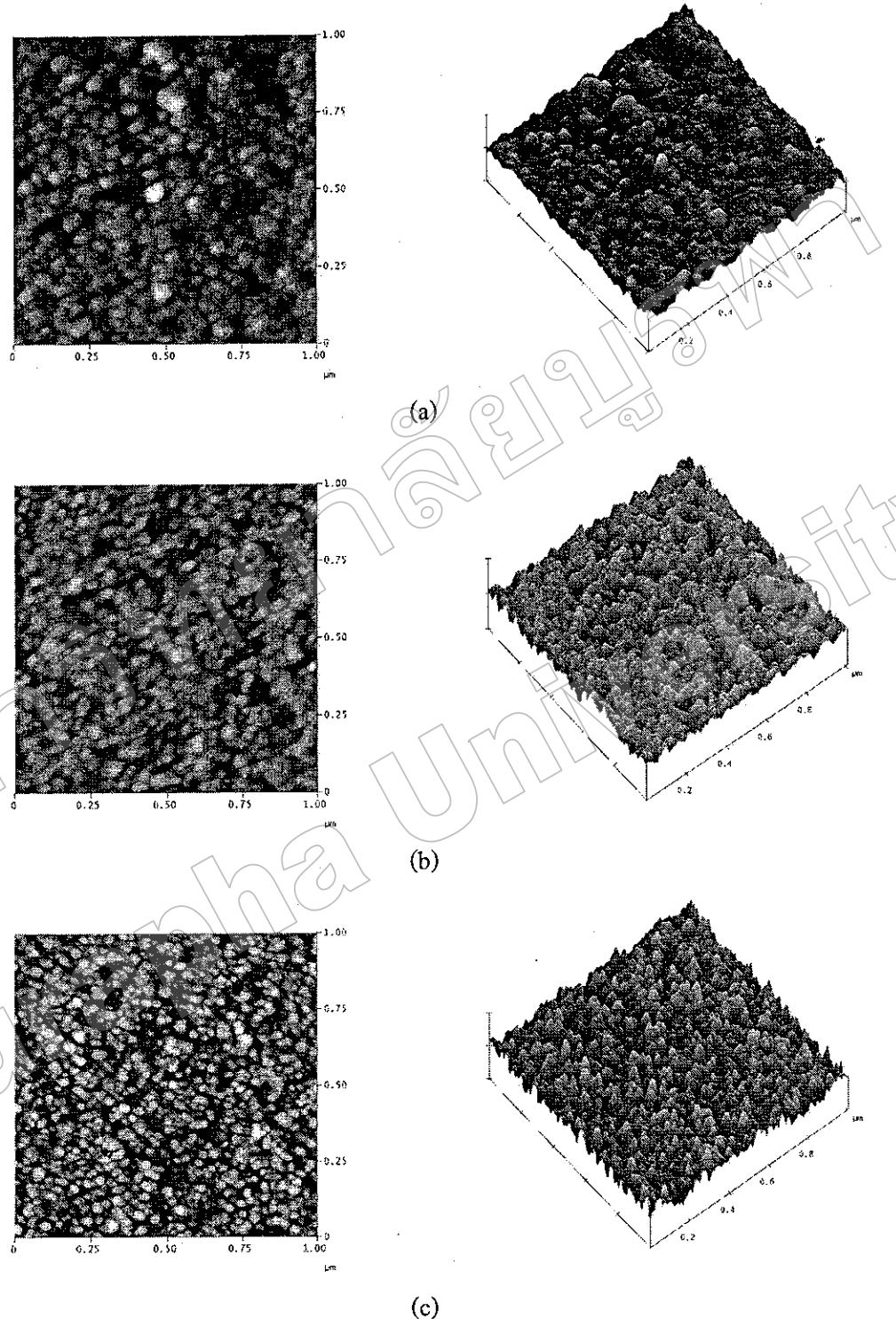


ภาพที่ 4-3 รูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได้ และผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

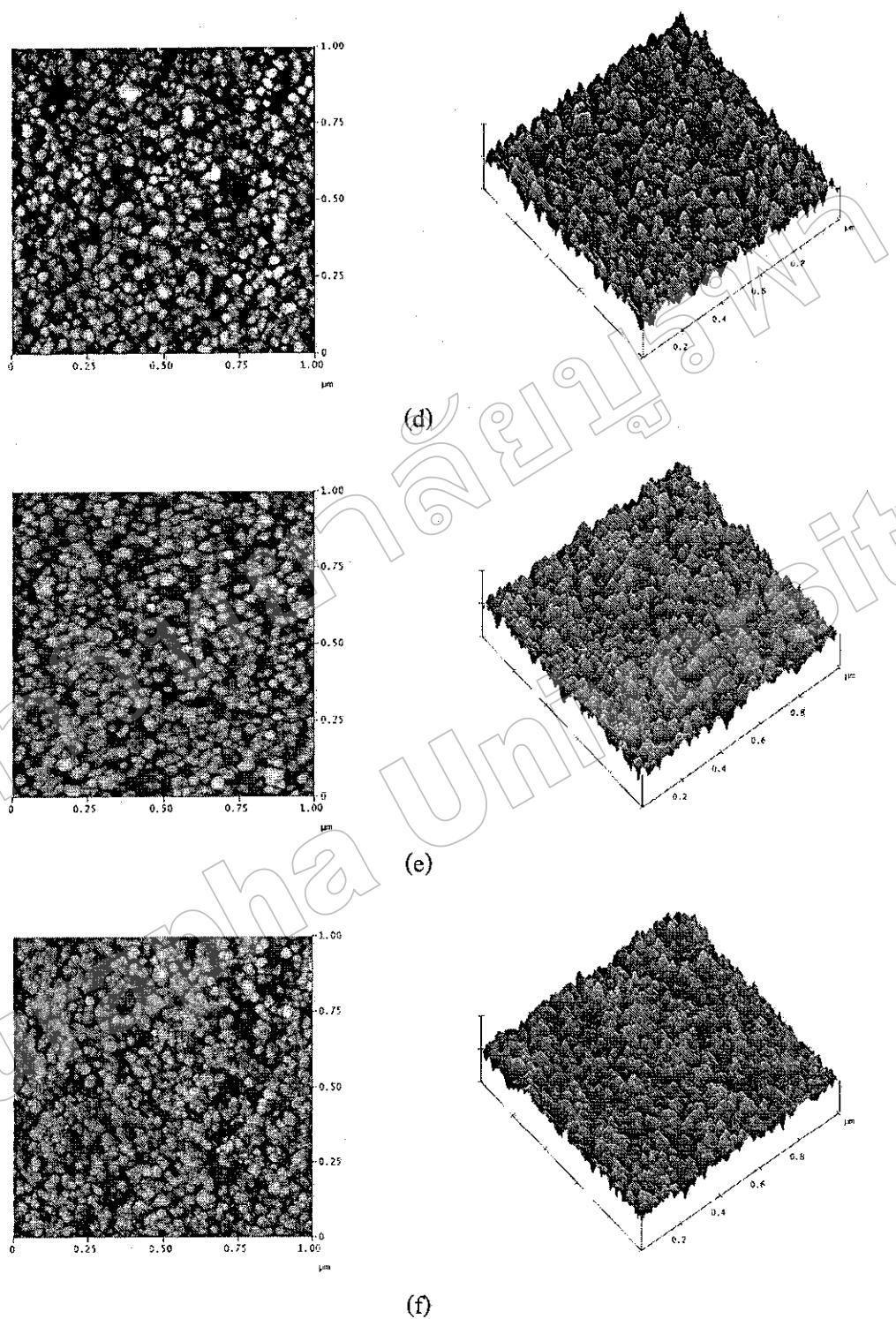
ผลของการอบอ่อนที่มีต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ นอกจากอุณหภูมิอบอ่อนจะมีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางแล้วอุณหภูมิอบอ่อนยังส่งผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางด้วย ในการทดลองนี้นำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400 และ 500 °C และนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM โดยใช้พื้นที่ในการวิเคราะห์เท่ากับ $1 \times 1 \mu\text{m}^2$ ซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4-4

ภาพที่ 4-4 แสดงสภาพพื้นผิวและภาพ 3 มิติของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิการอบอ่อนต่าง ๆ ซึ่งพบว่า ฟิล์มบางที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง พื้นผิวมีสภาพขรุขระ ขนาดของเกรนไม่สม่ำเสมอ และมีลักษณะกลมมน ความชรุขระเฉลี่ยมีค่า 1.37 nm เมื่ออบอ่อนฟิล์มบางที่อุณหภูมิ 100°C ขนาดของเกรนเริ่มมีขนาดเล็กลง และเกรนเริ่มมีลักษณะแหลมขึ้น ความชรุขระเฉลี่ยมีค่า 1.51 nm

ที่อุณหภูมิอบอ่อน 200°C พบว่าเกรนมีลักษณะคล้ายปลายเข็ม และมีขนาดเล็กกว่าเกรนที่อุณหภูมิอบอ่อน 100°C ความชรุขระเฉลี่ยมีค่า 1.96 nm ในขณะที่ฟิล์มบางที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C เกรนเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังคงมีลักษณะคล้ายปลายเข็ม ความชรุขระเฉลี่ยมีค่า 1.99 nm ที่อุณหภูมิอบอ่อน 400°C พบว่าเกรนเริ่มเกาะกันแน่นขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น ความชรุขระเฉลี่ยมีค่า 1.74 nm และที่อุณหภูมิอบอ่อน 500°C ก็เช่นกัน เกรนเริ่มมีลักษณะกลมมน และมีแนวโน้มที่เกรนจะรวมตัวกัน ความชรุขระเฉลี่ยมีค่า 1.69 nm



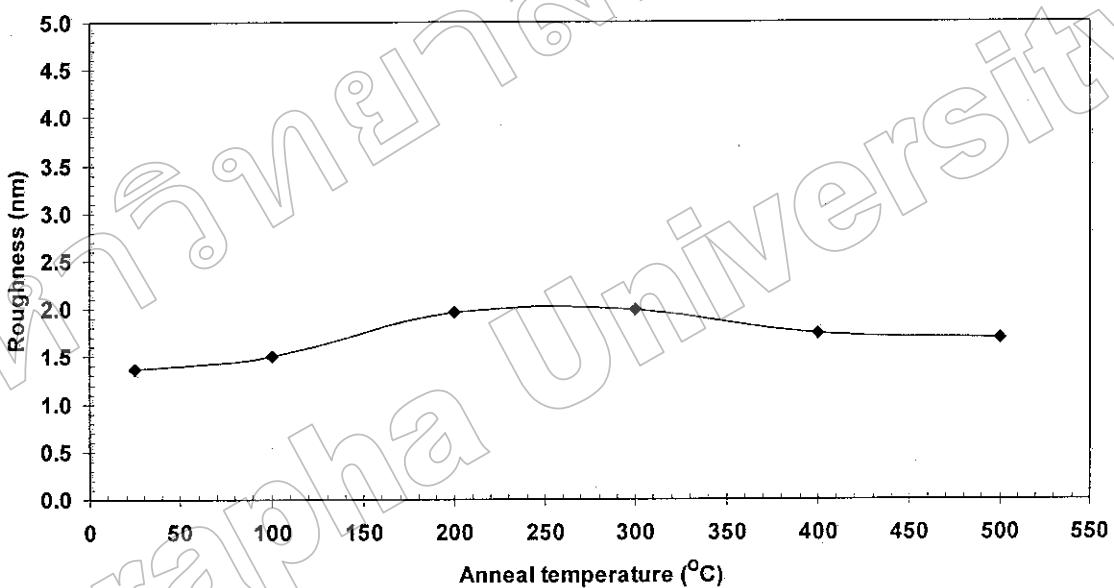
ภาพที่ 4-4 สภาพพื้นผิวและภาพ 3 มิติของฟิล์มบางไทดานียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิการอบอ่อนต่างๆ (a) อุณหภูมิห้อง, (b) 100 °C, (c) 200 °C, (d) 300 °C, (e) 400 °C และ (f) 500 °C



ภาพที่ 4-4 (ต่อ)

ตารางที่ 4-2 ค่าความขรุขระของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do開啟ใช้ด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

อุณหภูมิการอบอ่อน ($^{\circ}\text{C}$)	ความขรุขระ (nm)
อุณหภูมิห้อง	1.37
100	1.51
200	1.96
300	1.99
400	1.74
500	1.69



ภาพที่ 4-5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความขรุขระของพื้นผิวกับอุณหภูมิอบอ่อน

นำฟิล์มบางที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องและฟิล์มบางที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ไปหาค่าความขรุขระของพื้นผิวด้วยเทคนิค AFM พบร่วมกับเมื่ออุณหภูมิการอบอ่อนสูงขึ้นความขรุขระจะมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.37 nm ของฟิล์มที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง เป็น 1.51, 1.96 และ 1.99 nm ที่อุณหภูมิอบอ่อน 100, 200 และ 300 $^{\circ}\text{C}$ ตามลำดับ และมีค่าลดลงเป็น 1.74 และ 1.69 ที่อุณหภูมิอบอ่อน 400 และ 500 $^{\circ}\text{C}$ ตามลำดับ

ผลของอุณหภูมิอบอ่อนที่มีต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do開啟ใช้ด์

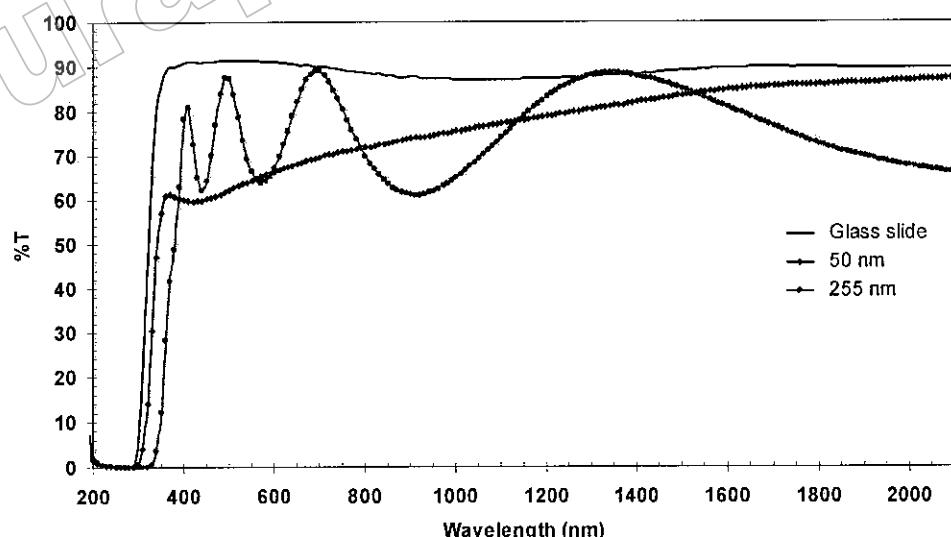
สมบัติทางแสงเป็นสมบัติเด่นของฟิล์มบางไททาเนียมไ/do開啟ใช้ด์ ซึ่งสิ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อสมบัติทางแสงคืออัตราที่หักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญ โดยวิธีการหาด้านี้หักเห

และสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณการถอยหลังที่ไม่ต่ำกว่า 0.9 และสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณที่ต่ำกว่า 0.1 Envelope Envelope เป็นวิธีการหาดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสัญญาณ โดยใช้เพียงค่าการส่งผ่านแสงอย่างเดียว โดยนำฟิล์มนางที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400 และ 500°C และนำไปวัดค่าเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงด้วยเครื่อง Spectrophotometer ได้ผลดังภาพที่ 4-7

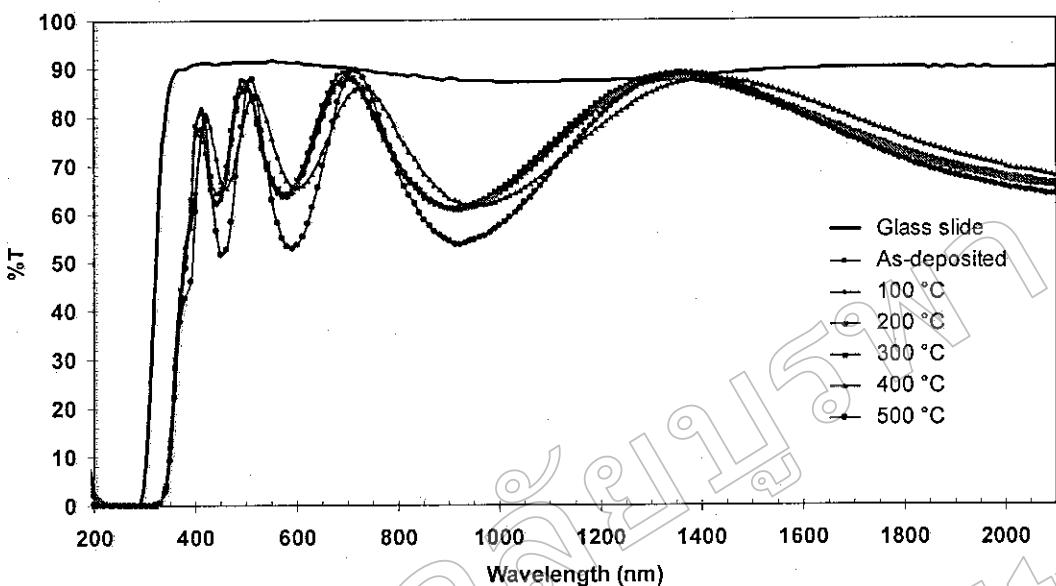
จากภาพที่ 4-6 แสดงスペกตรัมการส่งผ่านแสงของกระจกและฟิล์มที่ความหนาต่างกันพบว่า กระจกสไลด์ที่ไม่ได้เคลือบฟิล์ม ในช่วงความยาวคลื่น 200-300 nm (ช่วงของแสงอัลตราไวโอเลต, UV) มีเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงน้อยมาก (ไม่ถึง 1%) ในช่วงความยาวคลื่น 300-2100 nm (ช่วงของการส่องผ่านแสงที่ตามองเห็นและช่วงอินฟราเรด) เบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงประมาณ 90% และลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะคงที่

กระจกสไลด์ที่เคลือบด้วยฟิล์มที่มีความหนาประมาณ 50 nm ในช่วงความยาวคลื่น 200-300 nm มีเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเท่ากับกระจกสไลด์ที่ไม่ได้เคลือบฟิล์ม คือ เบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงไม่ถึง 1% ในช่วงความยาวคลื่น 300-2100 nm เบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงประมาณ 60% และลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 84%

กระจกสไลด์ที่เคลือบด้วยฟิล์มที่มีความหนาประมาณ 255 nm ในช่วงความยาวคลื่น 200-300 nm มีเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงไม่ถึง 1% ในช่วงความยาวคลื่น 300-2100 nm เบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงประมาณ 80% และลดลงอย่างรวดเร็วเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นตลอดช่วงความยาวคลื่นดังกล่าว ซึ่งลักษณะเช่นนี้แสดงถึงริ้วร้าวแทรกสอดที่เกิดจากฟิล์มที่เคลือบบนกระจกสไลด์



ภาพที่ 4-6 สเปกตรัมการส่งผ่านแสงของกระจกสไลด์และฟิล์มที่ความหนาต่างกัน



ภาพที่ 4-7 เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์มนางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

จากภาพที่ 4-7 เป็นค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์มนางไททาเนียมไดออกไซด์ที่ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ พนวจ ฟิล์มที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง ในช่วงความยาวคลื่น 200-300 nm เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีค่าน้อยมาก (น้อยกว่า 1%) ในช่วงความยาวคลื่น 300-2100 nm เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ลดลง เป็นเช่นนี้ตลอด ช่วงความยาวคลื่น เมื่อนำฟิล์มไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100°C พนวจ สเปกตรัมการส่งผ่านแสงนี้ ลักษณะเหมือนกับสเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิล์มที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง แต่ค่าเปอร์เซ็นต์ การส่งผ่านแสงมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทำให้สเปกตรัมการส่งผ่านแสงเดื่อนไปทางขวาเล็กน้อย ที่อุณหภูมิอบอ่อน 400°C พนวจ ช่วงของเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านมีค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด และลักษณะของรีวาร์กแทรกสอดเดื่อนไปทางขวาเล็กน้อย และที่อุณหภูมิอบอ่อน 500°C รีวาร์กแทรกสอดเดื่อนไปทางซ้ายเมื่อเทียบกับรีวาร์กแทรกสอดที่อุณหภูมิอบอ่อน 400°C

จากการแทรกสอดของคลื่นแสงที่ผ่านชั้นของฟิล์มนางไททาเนียมไดออกไซด์ที่ผ่าน การอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน เมื่อนำมาการส่งผ่านแสงที่ได้ไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยของการส่งผ่าน แสงในช่วงที่ตามองเห็น ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4-3

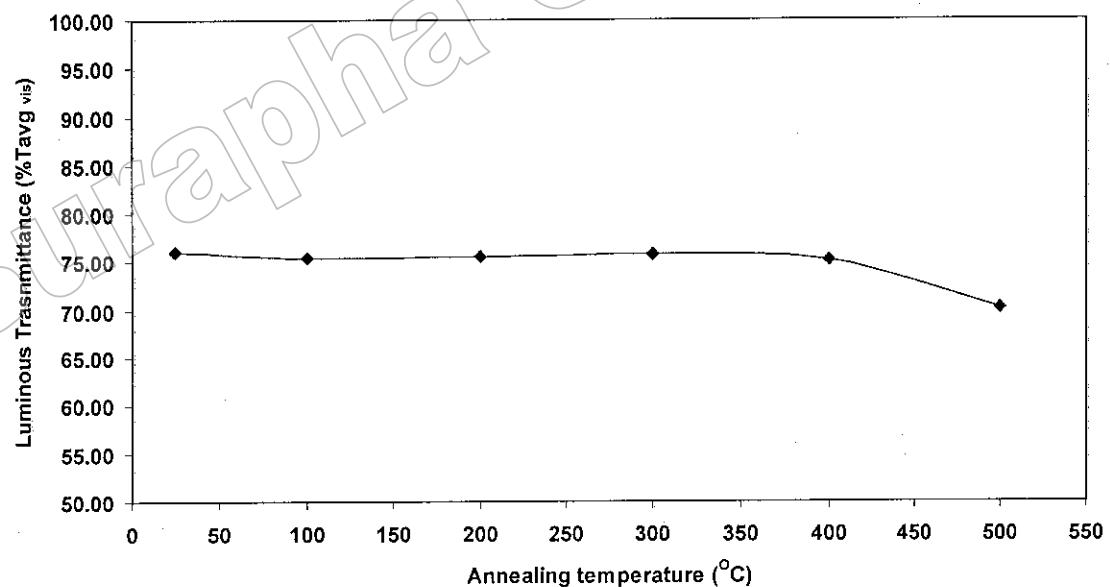
จากตารางที่ 4-3 พนวจ เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงที่ความยาวคลื่น 550 nm ของฟิล์มที่ เคลือบที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิอบอ่อน $100, 200$ และ 300°C มีค่าใกล้เคียงกันที่ $66.37, 66.97, 66.46$ และ 67.57 ตามลำดับ เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มเป็น 400°C เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงเพิ่มขึ้น เป็น 75.67 และลดลงเหลือ 63.11 ที่อุณหภูมิอบอ่อน 500°C

ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงในช่วงการส่งผ่านแสงที่ตามองเห็นของฟิล์มที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิอบอ่อน 100, 200, 300, 400 และ 500 °C มีค่าไม่ต่างกันมากนัก คือ 76.09, 75.43, 75.51, 75.80, 75.21 และ 70.20 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มสูงขึ้น ค่าเฉลี่ยเบอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีแนวโน้มที่จะลดลง

ตารางที่ 4-3 การส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง ไทยเนียม ไ/do/ok ไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

อุณหภูมิอบอ่อน (°C)	% การส่งผ่านแสงที่ 550 nm	% การส่งผ่านแสงเฉลี่ย*
อุณหภูมิห้อง	66.37	76.09
100	66.97	75.43
200	66.46	75.51
300	67.57	75.80
400	75.67	75.21
500	63.11	70.20

หมายเหตุ * การส่งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงการส่งผ่านแสงที่ตามองเห็น (380-780 nm)



ภาพที่ 4-8 กราฟแสดงการส่งผ่านแสงเฉลี่ยในช่วงที่ตามองเห็นที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

ตารางที่ 4-4 ดัชนีหักเห และสัมประสิทธิ์การดับสูญที่ความยาวคลื่น 550 nm ของฟิล์มบาง
ไทยเนี่ยม ได้ออกใช้ค์ที่อุณหภูมิการอบอ่อนต่าง ๆ

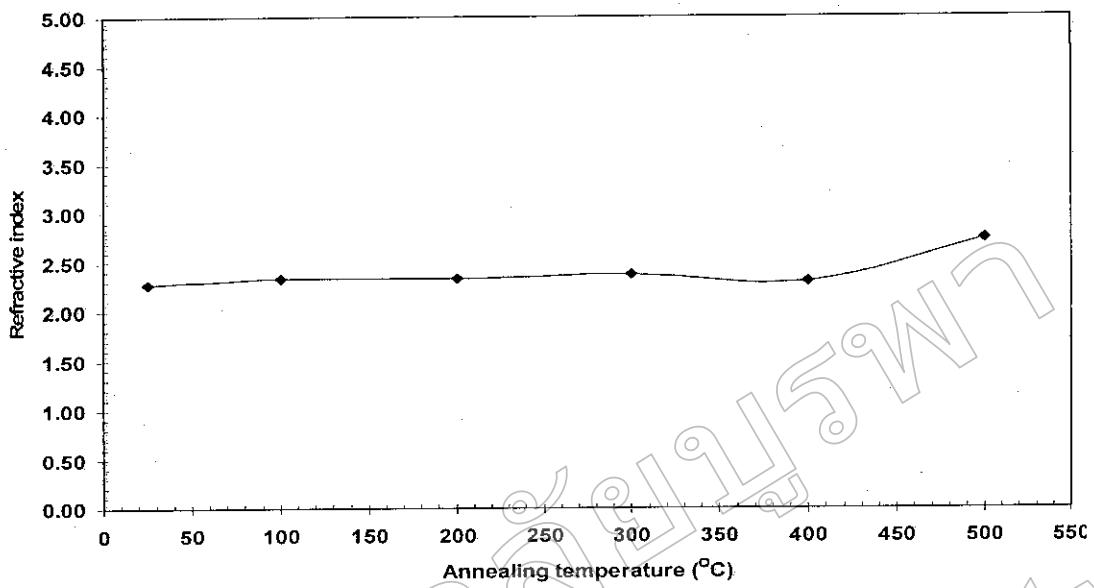
อุณหภูมิการอบอ่อน ($^{\circ}\text{C}$)	ดัชนีหักเห	สัมประสิทธิ์การดับสูญ
อุณหภูมิห้อง	2.28	0.009
100	2.33	0.007
200	2.34	0.007
300	2.37	0.006
400	2.30	0.009
500	2.74	0.003

นอกจากนี้ค่าการส่งผ่านスペกตรัมยังสามารถนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าคงที่ทางแสง (ดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ) ได้โดยใช้วิธีที่เรียกว่า Envelope Method ซึ่งผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 4-4

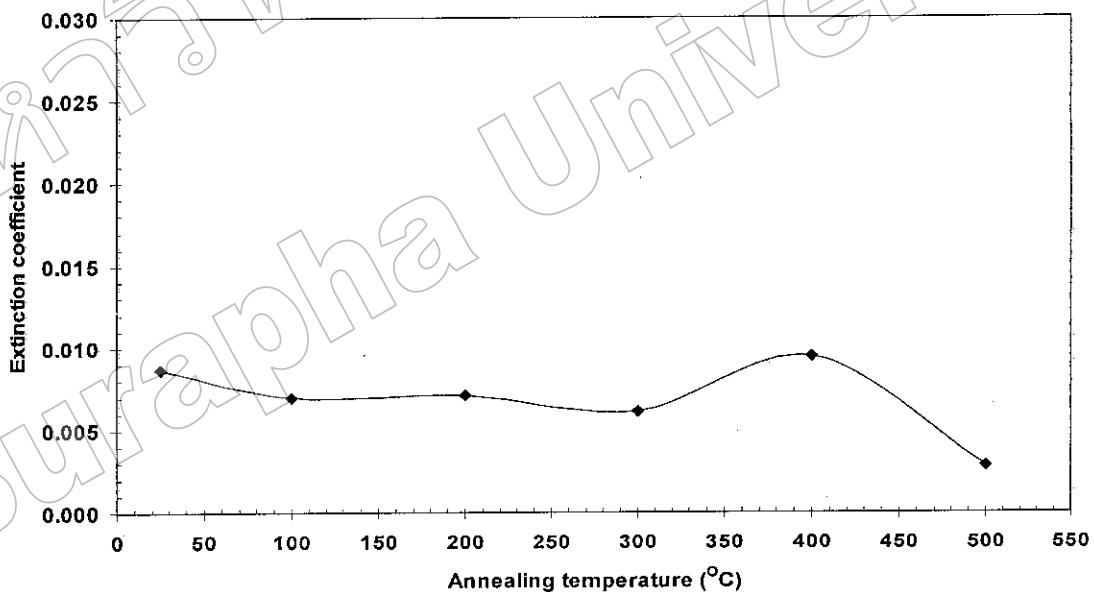
จากตารางที่ 4-4 ดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญที่ความยาวคลื่น 550 nm ของฟิล์มบางไทยเนี่ยม ได้ออกใช้ค์ที่อุณหภูมิการอบอ่อนต่าง ๆ พนว่า ดัชนีหักเหมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 2.28 เป็น 2.33, 2.34 และ 2.37 ที่ฟิล์มที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง ฟิล์มที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200 และ 300 $^{\circ}\text{C}$ ตามลำดับ ส่วนดัชนีหักเหที่อุณหภูมิ 400 $^{\circ}\text{C}$ กลับมีค่าลดลงเหลือ 2.30 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.74 เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเป็น 500 $^{\circ}\text{C}$

ส่วนสัมประสิทธิ์การดับสูญที่ความยาวคลื่น 550 nm พนว่า มีค่าลดลงจาก 0.009 เป็น 0.007, 0.007 และ 0.006 ที่ฟิล์มที่เคลือบที่อุณหภูมิห้อง ฟิล์มที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 100, 200 และ 300 $^{\circ}\text{C}$ ตามลำดับ และที่อุณหภูมิอบอ่อน 400 $^{\circ}\text{C}$ สัมประสิทธิ์การดับสูญเพิ่มขึ้นเป็น 0.009 และลดลงเป็น 0.003 ที่อุณหภูมิอบอ่อน 500 $^{\circ}\text{C}$

จากการที่ 4-11 แสดงดัชนีหักเหของฟิล์มบางไทยเนี่ยม ได้ออกใช้ค์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ แบรคค่าความยาวคลื่น พนว่า เมื่อความยาวคลื่นเพิ่มขึ้น ค่าดัชนีหักเหจะมีค่าลดลง เช่นเดียวกับสัมประสิทธิ์การดับสูญ



ภาพที่ 4-9 ดัชนีหักเหของพิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ



ภาพที่ 4-10 สัมประสิทธิ์การดับสัญญาณพิล์มบางไททาเนียมไคออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ

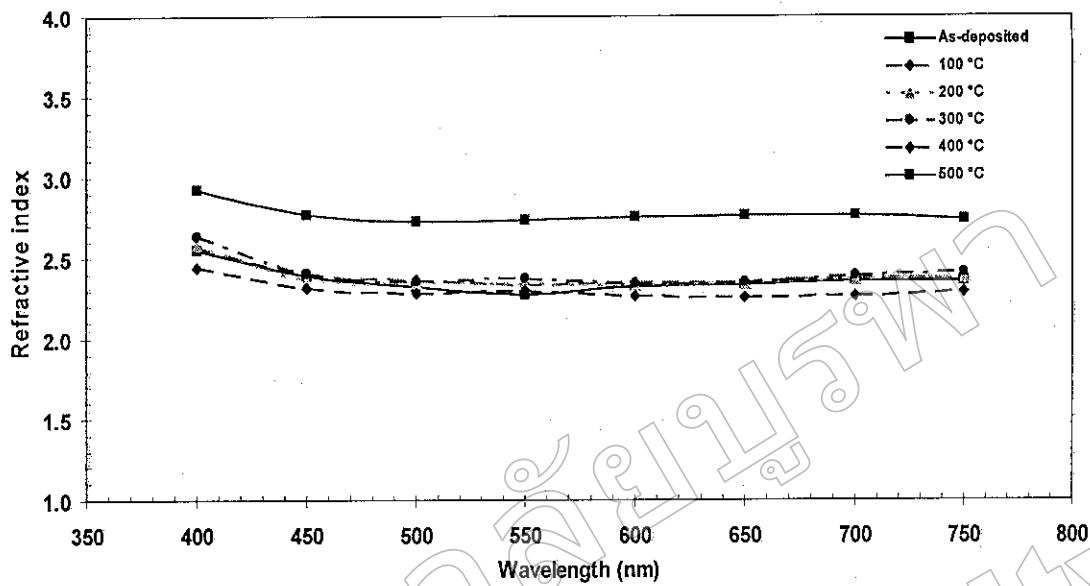
ตารางที่ 4-5 ดัชนีหักเหของฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ แบรค์ตามความยาวคลื่น

ความยาวคลื่น (nm)	อุณหภูมิอบอ่อน					
	อุณหภูมิห้อง	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C
400	2.55	2.57	2.59	2.63	2.44	2.92
450	2.39	2.40	2.36	2.41	2.32	2.77
500	2.32	2.37	2.35	2.35	2.28	2.73
550	2.28	2.33	2.34	2.37	2.30	2.74
600	2.32	2.34	2.33	2.34	2.27	2.76
650	2.33	2.35	2.34	2.35	2.26	2.76
700	2.36	2.37	2.36	2.39	2.26	2.77
750	2.36	2.37	2.37	2.41	2.28	2.74

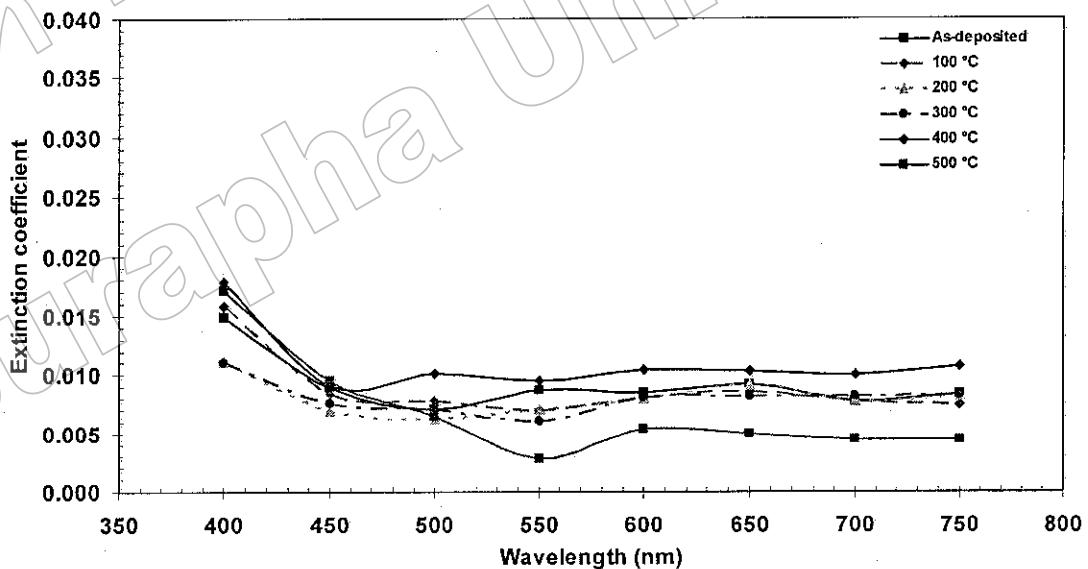
ตารางที่ 4-6 สัมประสิทธิ์การดับสัญญาณฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ แบรค์ตามความยาวคลื่น

ความยาวคลื่น (nm)	อุณหภูมิอบอ่อน					
	อุณหภูมิห้อง	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C	500 °C
400	0.015	0.016	0.011	0.011	0.018	0.017
450	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009
500	0.007	0.008	0.006	0.007	0.010	0.007
550	0.009	0.007	0.007	0.006	0.009	0.003
600	0.009	0.008	0.008	0.008	0.010	0.005
650	0.009	0.009	0.009	0.008	0.010	0.005
700	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.004
750	0.008	0.007	0.008	0.008	0.011	0.004

จากตารางที่ 4-5 และ ตารางที่ 4-6 สามารถนำมาเขียนกราฟได้ดังภาพที่ 4-11 และภาพที่ 4-12 ตามลำดับ



ภาพที่ 4-11 ดัชนีหักเหของฟิล์มบางไฟฟ้าเนยมไ/doaka/ไซด์ที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ แบรคตามความยาวคลื่น



ภาพที่ 4-12 ต้มประสิทธิ์การดับสัญญาณฟิล์มบางไฟฟ้าเนยมไ/doaka/ไซด์ที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ แบรคตามความยาวคลื่น